

**CBRHDSH1-100**  
**SURFACE MOUNT**  
**HIGH DENSITY**  
**1 AMP SILICON**  
**SCHOTTKY BRIDGE RECTIFIER**



[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

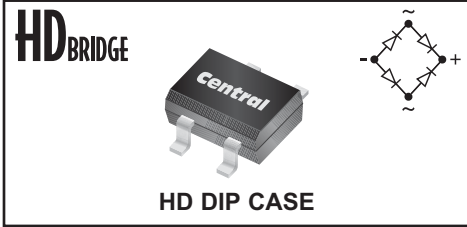
**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CBRHDSH1-100 is a full wave bridge rectifier in a durable epoxy surface mount molded case, designed for low voltage full wave rectification applications. The molding compound used in this device has UL flammability classification 94V-O.

**MARKING CODE: CSH110**

**FEATURES:**

- Low Leakage Current (40nA TYP @  $V_{RRM}$ )
- Low Forward Voltage Drop Schottky Diodes
- High 1.0A Current Rating



**MAXIMUM RATINGS:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

	SYMBOL		UNITS
Peak Repetitive Reverse Voltage	$V_{RRM}$	100	V
DC Blocking Voltage	$V_R$	100	V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	71	V
Average Forward Current	$I_O$	1.0	A
Peak Forward Surge Current	$I_{FSM}$	20	A
Power Dissipation	$P_D$	1.2	W
Operating Junction Temperature	$T_J$	-50 to +125	$^\circ\text{C}$
Storage Temperature	$T_{stg}$	-55 to +150	$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance	$\Theta_{JA}$	85	$^\circ\text{C/W}$

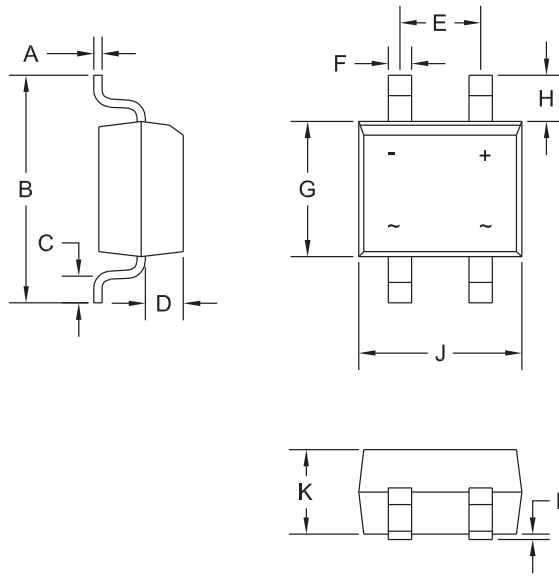
**ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE:** ( $T_A=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
$I_R$	$V_R=100\text{V}$		0.04	10	$\mu\text{A}$
$I_R$	$V_R=100\text{V}, T_A=50^\circ\text{C}$			1.0	mA
$I_R$	$V_R=100\text{V}, T_A=100^\circ\text{C}$			20	mA
$BV_R$	$I_R=150\mu\text{A}$	100			V
$V_F$	$I_F=500\text{mA}$		615	700	mV
$V_F$	$I_F=1.0\text{A}$		690	750	mV
$C_J$	$V_R=4.0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$		230		pF

**CBRHDSH1-100**  
**SURFACE MOUNT**  
**HIGH DENSITY**  
**1 AMP SILICON**  
**SCHOTTKY BRIDGE RECTIFIER**



**HD DIP CASE - MECHANICAL OUTLINE**



R2

<b>DIMENSIONS</b>				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.006	0.014	0.15	0.35
B	-	0.275	-	7.00
C	0.027	0.043	0.70	1.10
D	0.035	0.051	0.90	1.30
E	0.090	0.106	2.30	2.70
F	0.019	0.031	0.50	0.80
G	0.150	0.165	3.80	4.20
H	0.051	0.067	1.30	1.70
J	0.177	0.193	4.50	4.90
K	0.090	0.106	2.30	2.70
L	0.000	0.008	0.00	0.20

HD DIP (REV: R2)

**MARKING CODE: CSH110**

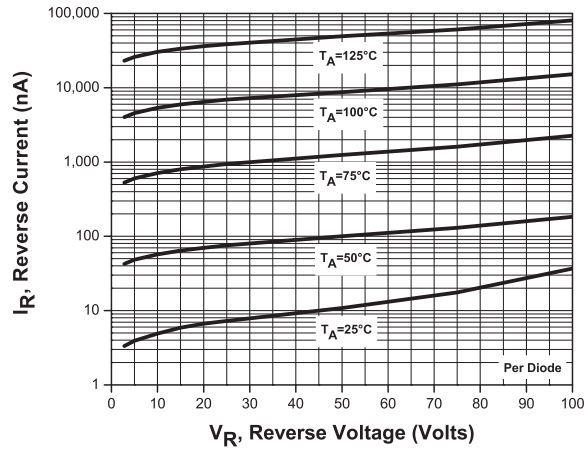
R6 (22-May 2012)

**CBRHDSH1-100**  
**SURFACE MOUNT**  
**HIGH DENSITY**  
**1 AMP SILICON**  
**SCHOTTKY BRIDGE RECTIFIER**

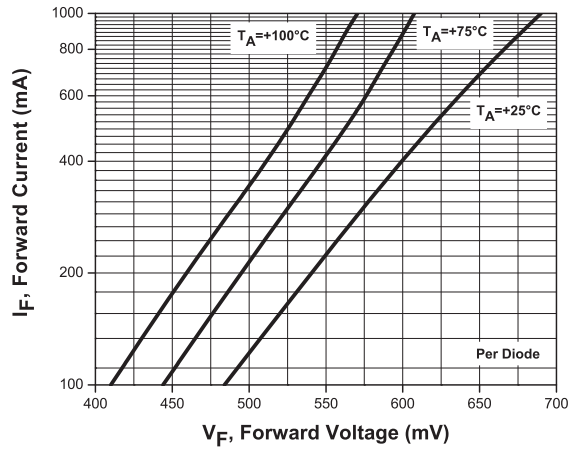


**TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

**Typical Leakage Current**



**Typical Forward Voltage**



R6 (22-May 2012)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.